

Государственный научный центр Российской Федерации

Акционерное общество «НПО «Орион» 111538, Россия Москва, ул. Косинская, 9

факс: 8 (499) 373 68 62

orion@orion-ir.ru

OFPH 112 774 729 27 38 тел.: 8 (499) 374 48 60

Enterprise «RD&P Center «Orion» 9, Kosinskaya St., Moscow 111538, Russian Federation

tel.: 8 (499) 374 48 60 fax: 8 (499) 373 68 62 orion@orion-ir.ru

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Григорьевой Людмилы Николаевны «Влияние частиц систем множественных квантовых карбида кремния на фотопроводимость GaAs/AlGaAs», представленной на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 1.3.11 – «Физика полупроводников».

Диссертационная работа Л.Н. Григорьевой посвящена исследованию и разработке новых методов и подходов для увеличения фоточувствительности средневолновых и A3B5 фотоприемных устройств на основе инфракрасных длинноволновых наногетероструктур с множественными квантовыми ямами, которые широко применяются в современных тепловизионных системах, что, на сегодняшний день, является актуальной и практически значимой задачей.

В диссертационной работе предложено и реализовано гибридное фотопроводящее устройство с нанесенными на рабочую поверхность наногетероструктуры микрочастиц карбида кремния. В следствии чего было продемонстрировано увеличение сигнала фотопроводимости в 1.5-1.8 раза. Кроме этого, диссертантом предложены возможные пути оптимизации параметров гибридного ФПУ с квантовыми ямами GaAs/AlGaAs и микрочастицами SiC для дальнейшего увеличения фоточувствительности в подобной системе.

Все экспериментальные данные получены с помощью современных, широкораспространённых методов изготовления и анализа образцов. Был проведён подробный анализ и сопоставление результатов схожих по тематике работ других исследовательских групп. Исходя из вышеизложенного, достоверность и обоснованность результатов не вызывают сомнений, а полученные результаты представляют ощутимый практический интерес для устройств оптоэлектроники.

Автореферат содержит достаточное количество исходных данных для полного понимания содержания диссертационной работы, имеет пояснения, рисунки, графики. Написан технически квалифицированно и аккуратно оформлен.

В целом диссертационная работа Л.Н. Григорьевой, посвящена решению актуальной современной проблемы и производит очень хорошее впечатление. Результаты экспериментальных исследований и теоретических расчетов имеют важное прикладное значение. Материалы диссертации прошли апробацию на профильных международных и российских конференциях по физике полупроводников и спектроскопии, широко представлены в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах из перечня ВАК. По объему полученных результатов, их актуальности и важности данная работа, без сомнения, соответствует требованиям предъявляемых ВАК, а её автор, Григорьева Людмила Николаевна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 1.3.11 – Физика полупроводников.

Начальник участка фоточувствительных материалов серийного производства АО «НПО «Орион» кандидат физико-математических наук

Е.А. Климов

Подпись Е.А. Климова заверяю:

Ученый секретарь АО «НПО «Орг

кандидат технических наук

«<u>Ов</u>» шарта 2023 г.

А.В. Егоров